



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

**H558**

对应国外型号

BC558

**主要用途**

开关、视频放大。

**外形图及引脚排列**

**极限值 (T<sub>a</sub>=25 )**

T <sub>stg</sub>	——贮存温度.....	-55~150
T <sub>j</sub>	——结温.....	150
P <sub>C</sub>	——集电极耗散功率.....	500mW
V <sub>CB0</sub>	——集电极—基极电压.....	-30V
V <sub>CEO</sub>	——集电极—发射极电压.....	-30V
V <sub>EBO</sub>	——发射极—基极电压.....	-5V
I <sub>C</sub>	——集电极电流.....	-100mA



**电参数 (T<sub>a</sub>=25 )**

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV <sub>CB0</sub>	集电极—基极击穿电压	-30			V	I <sub>C</sub> =-100 μA, I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	-30			V	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	-5			V	I <sub>E</sub> =-100 μA, I <sub>C</sub> =0
I <sub>CB0</sub>	集电极—基极截止电流			-15	nA	V <sub>CB</sub> =-30V, I <sub>E</sub> =0
H <sub>FE</sub>	直流电流增益	110		800		V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-2mA
V <sub>CE(sat1)</sub>	集电极—发射极饱和电压	-90		-300	mV	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =-0.5mA
V <sub>CE(sat2)</sub>		-250		-650	mV	I <sub>C</sub> =-100mA, I <sub>B</sub> =-5mA
V <sub>BE(sat1)</sub>	基极—发射极饱和电压	-700			mV	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =-0.5mA
V <sub>BE(sat2)</sub>		-900			mV	I <sub>C</sub> =-100mA, I <sub>B</sub> =-5mA
V <sub>BE(on1)</sub>	基极—发射极导通电压	-660		-750	mV	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-2mA
V <sub>BE(on2)</sub>				-800	mV	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-10mA
f <sub>T</sub>	特征频率		150		MHz	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-10mA, f=1MHz
C <sub>ob</sub>	输出电容			6	pF	V <sub>CE</sub> =-10V, I <sub>C</sub> =0, f=1MHz

**分档及其标志**

A

B

C

110—220

200—450

420—800

